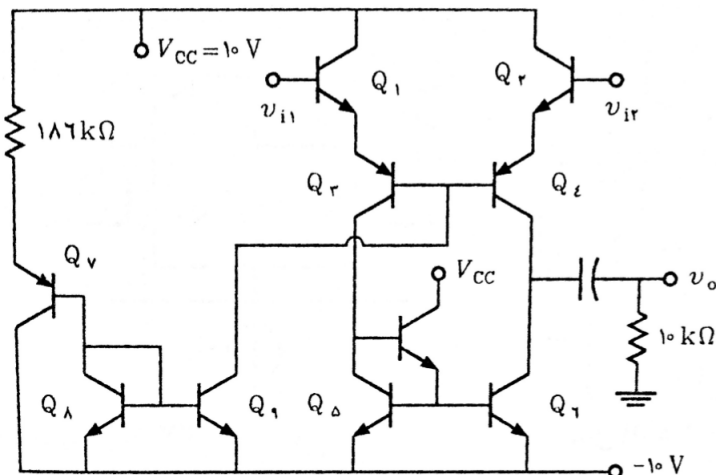




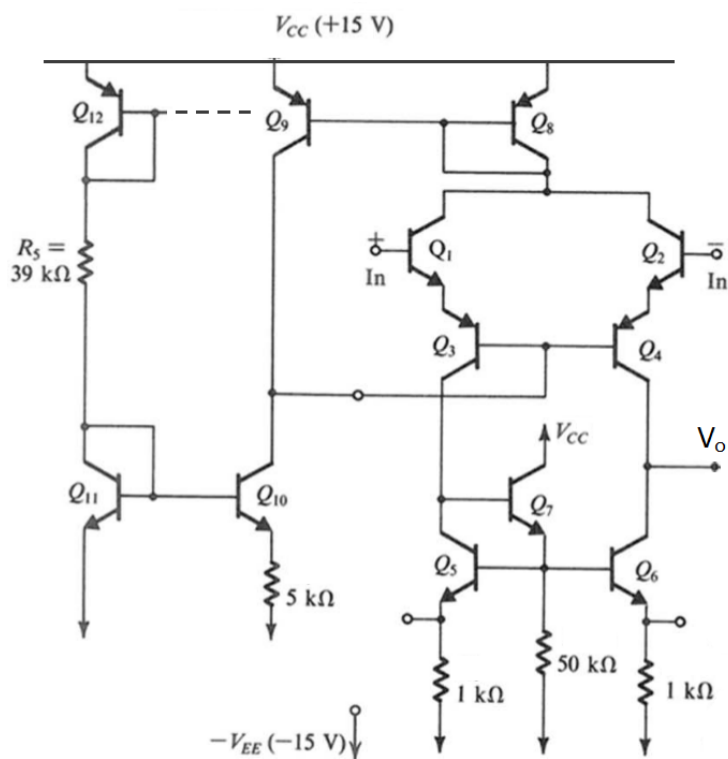
۷. در مدار شکل زیر جریان نقطه کار ترانزیستورها، بهره $A_v = \frac{v_o}{v_{id}}$ و مقاومت ورودی تفاضلی را محاسبه کنید.

$$\beta = 100, \quad |V_{BE(on)}| = 0.7v, \quad V_A = 100v$$



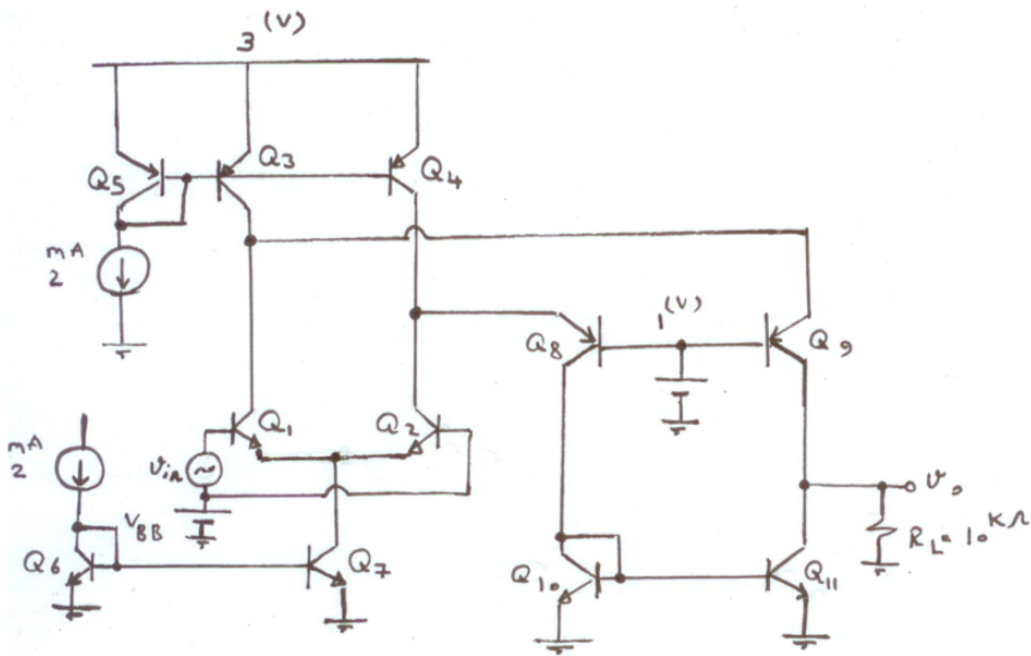
۸. مدار شکل زیر طبقه ورودی OP-AMP 741 را نشان می دهد. جریان نقطه کار ترانزیستورها، بهره تفاضلی و بهره حالت مشترک را محاسبه کنید.

$$\beta_{npn} = 200, \quad \beta_{pnp} = 50, \quad V_{A(npn)} = 125v, \quad V_{A(pnp)} = 50v$$

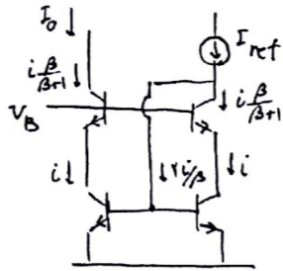




۹. با فرض $V_{BE(on)} = 0.7v$ و $V_A = 100v$ و $\beta_{npn} = 2\beta_{pnp} = 100$ به سوالات زیر پاسخ دهید.



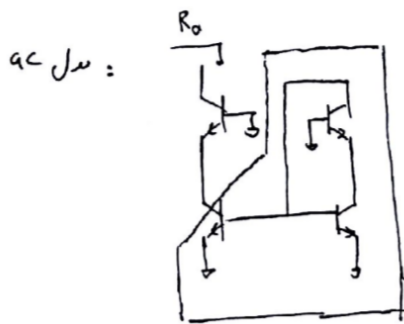
- (ا) نقاط کار ترانزیستورها را محاسبه کنید.
- (ب) مقاومت دیده شده از دو سر منبع سیگنال ورودی و مقاومت خروجی را محاسبه کنید.
- (ج) بهره سیگنال کوچک $A_v = \frac{v_o}{v_{in}}$ را به دست آورید.
- (د) ماکزیمم *Swing* خروجی را محاسبه کنید.
- (ه) محدوده مجاز ولتاژ V_{BB} را بدست آورید.



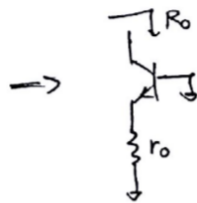
$$I_{ref} = i \frac{\beta}{\beta+1} + 2i/\beta \Rightarrow I_a = I_{ref} \frac{\beta/\beta+1}{\beta/\beta+1 + 1/\beta} \approx I_{ref} (1 - \frac{1}{\beta}) \quad (\text{الف})$$

$$I_o = i \frac{\beta}{\beta+1}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{I_o - I_{ref}}{I_{ref}} \right| \approx \frac{1}{\beta}$$



(ب) جهت قرار گرفته در مدار به تغییر فریقه جداگانه از منبع مدار هسته که هیچ دردت ندارند پس هر دو ولتاژ در آن معرالفست.



$$R_o = r_o (1 + g_m r_{\pi} || r_o) = \beta r_o$$

$$= \beta \frac{V_A}{I_{ref}}$$

(ج) حاصل ولتاژ لازم برای روشن ماندن مدار در اشباع نشدن آن ($V_{cs,min}$) با شرط $V_{ce} \geq 0.1V$ تعیین می شود. لذا:

$$V_{cs,min} = V_B - 0.1V + 0.1V = V_B - 0.1V$$

$$V_B - 0.1V \geq 0.1V \Rightarrow V_B \geq 0.2V$$

از طرفی برای اشباع نشدن Q_4 :

لذا برای دامن گسترین $V_{cs,min}$: $V_B = 0.19V$ در این حالت: $V_{cs,min} = 0.09V$

(می توانند بنویسند با این اعداد Q_1 و Q_3 همیان active هستند.)

	cascade	این مدار
R_o	βr_o	$< \beta r_o$
$V_{cs,min}$	$0.19V$	$< 0.19V$

(د)



(ب)

بررسی بایاس:

$$I_{CQ} = I_{C10} = \frac{-0.1V - (-2)}{21.2K} = 1m$$

مقادیر $I_{C10} = 1m$

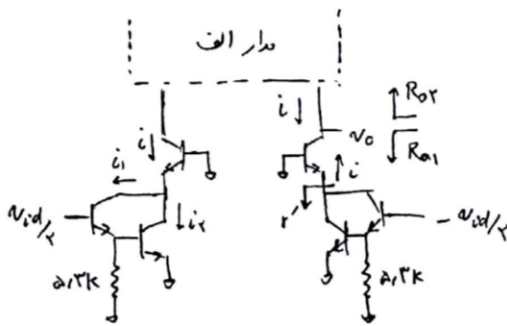
$$\begin{aligned} g_m &= 40m \\ r_{\pi} &= 210K \\ r_o &= 100K \end{aligned}$$

می‌توانید ترانزیستور را در ناحیه فعال حسند. نملاً نتایج به حساب V_{CE} بخنداریم.

مدار معادل حالت تعاضلی:

از کنگر $G_m R_o$ استفاده می‌کنیم.

حاسب G_m :



$$i_1 = \frac{v_{id}}{2} \frac{1}{21.2K \parallel r_{\pi} + r_m}$$

$$i_2 = \frac{v_{id}}{2} \frac{21.2K \parallel r_{\pi}}{21.2K \parallel r_{\pi} + r_m} \times g_m$$

$$\Rightarrow i = \frac{v_{id}}{2} g_m \Rightarrow i_{out} = 2i = g_m v_{id}$$

$$\Rightarrow G_m = g_m = 40mV$$
 (I)

حاسب R_o :

با توجه به این که معادلت دیده شده از کالکولر Q_1 و Q_2 بسیار نزدیک است، نتیجتاً به حساب R_o می‌کنیم! (تقریباً می‌کنیم آن را حاسب کنید!)

$$R_{o1} = r_o (1 + g_m r_{\pi} \parallel r_c) \approx \beta r_o$$

$$\Rightarrow R_{o2} = \beta r_o$$

$$\Rightarrow R_o = \frac{\beta}{2} r_o$$
 (II)

$$\Rightarrow A_{vd} = g_m \frac{\beta}{2} r_o = 200k$$
 (I و II)

$$R_i = 2 (r_{\pi} + \beta (21.2K \parallel r_{\pi})) \approx 240k$$
 (د)

حاسب CMR:

$$V_{CS} \geq V_{CS, min} \Rightarrow v_{cm}^- = V_{E1} - (-2) - 0.12 = 2 - 1.14 - 0.12 = 0.74V$$

$$V_{CE9} \geq 0.12 \Rightarrow v_{cm}^+ = V_{CE9} - 0.12 = (1 - 0.1V) - (-0.1V) - 0.12 = 0.18V$$

$$\Rightarrow CMR = [-0.74 \quad 0.18] \rightarrow 21.2V$$